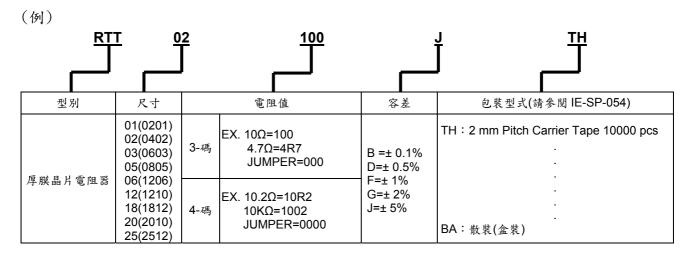
厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	1/13

1 適用範圍:

- 1.1 本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之RTT系列厚膜晶片電阻器。
- 1.2 本公司之無鉛產品意指符合RoHS要求的端電極無鉛,而存在於電阻層玻璃材料中的 鉛是符合RoHS的鉛排外條款。

2 型別名稱:



3 規格表:

3.1 阻值範圍:≥1Ω & 0Ω

型別	類定 最高 最高 T.C.R 額定 額定 過負荷 (ppm/℃)				阻值範圍				JUMPER (0Ω) 額定電流		JUMPER (0Ω) 阻值	
	カキ	電壓	電壓	溫度係數	B(±0.1%) E-24 \ E-96	D(±0.5%) E-24 \ E-96	F(±1%) E-24 \ E-96	G(±2%) \ J(±5%) E-24	J (±5%)	F (±1%)	J (±5%)	F (±1%)
RTT01 (0201)	<u>1</u> W	25V	50V	-200 +400		1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	0.5A	0.5A	50mΩ MAX.	35mΩ MAX.
(0201)	20			±200	$100\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	10Ω≦R≦10MΩ			WIAX.	IVI/A/X.
RTT02	W	50V	100V	±100	$100\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 1M\Omega$	$10\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!22M\Omega$	10Ω≦R≦22MΩ	4.0	1.5A	50mΩ	20mΩ
(0402)	1 16	50 V	1000	±200			1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	1A	1.5A	MAX.	MAX.
RTT03	1W	75V	150V	±100	$100\Omega {\le} R {\le} 1M\Omega$	$10\Omega {\le} R {\le} 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!22M\Omega$	10Ω≦R≦22MΩ	1A	2A	50mΩ	20mΩ
(0603)	10	750	130 V	±200		$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \le R < 10\Omega$	$1\Omega \le R < 10\Omega$	IA.	2/1	MAX.	MAX.
RTT05	_1_W	150V	300V	±100	$100\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	$10\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 27M\Omega$	10Ω≦R≦27MΩ	2A	2.5A	50mΩ	20mΩ
(0805)	8 VV	1507	3007	±200		1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	ZA	2.5A	MAX.	MAX.
RTT06	W	200V	400V	±100	$10\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!27M\Omega$	10Ω≦R≦27MΩ	2A	3.5A	50mΩ	20mΩ
(1206)	4	200V	4000	±200	$3\Omega \le R < 10\Omega$	$1\Omega \le R < 10\Omega$	1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	ZA	3.5A	MAX.	MAX.
RTT12	W	200V	400V	±100	$100\Omega {\le} R {\le} 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!27M\Omega$	10Ω≦R≦27MΩ	2A	4A	50mΩ	20mΩ
(1210)	2	2007	4000	±200			$1\Omega \le R < 10\Omega$	$1\Omega \le R < 10\Omega$	24	4/4	MAX.	MAX.
RTT18	_3_W	200V	400V	±100	$100\Omega {\le} R {\le} 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!20M\Omega$	10Ω≦R≦20MΩ	2A	5A	50mΩ	20mΩ
(1812)	4	200V	4000	±200			$1\Omega \le R < 10\Omega$	1Ω≦R<10Ω	ZA	ЭA	MAX.	MAX.
RTT20	_3_W	200V	400V	±100	$100\Omega {\le} R {\le} 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!20M\Omega$	10Ω≦R≦20MΩ	2A	5A	50mΩ	20mΩ
(2010)	4 VV	200 V	4007	±200			1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω	ZA)AC	MAX.	MAX.
RTT25	1W	200V	400V	±100	$100\Omega \! \leq \! R \! \leq \! 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!10M\Omega$		10Ω≦R≦20MΩ	2A	7A	50mΩ	20mΩ
(2512)			1001	±200			1Ω≦R<10Ω	1Ω≦R<10Ω		,,,	MAX.	MAX.
	使用温度範圍 -55℃ ~+155℃ (0201:-55℃ ~+125℃)											

	ΙΕ		QA	Sales	備註						發行管制章 DATA Ce	antar
制訂	審查	核准	會簽	會簽	非	發行	行 管	制	す	件	放打官的早 DATA O	critor.
制訂	304/	- 216	福汽车	可见双	白	行注		" 反 本	重	新		
- Joseph -	Joseph John Stranger	500h	子が伝	兴不巧	11- 45	11 11	- 心 //	久 4	"	2 7	Series No.60	
		1			非經	允許	,棠止	目行京	沙甲.	又仵		

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2014/11/28頁 次2/13

3.2 阻值範圍:<1Ω

		国士	旦 士	T.C.R	阻值範圍
型別	額定功率	最高 額定電流	最高 過負荷電流	(ppm / °C) 溫度係數	F(±1%) \ G(±2%) \ J((±5%) E-24 \ E-96
				±1500	25 mΩ \leq R $<$ 37 mΩ
				±1200	$37~\text{m}\Omega \leq R < 60~\text{m}\Omega$
RTT02	1/16W	1.58A	3.95A	±600	$60~\text{m}\Omega\!\leq\!R\!<\!200~\text{m}\Omega$
(0402)	17 10 00	1.50A	3.55A	±300	200 mΩ \leq R $<$ 400 mΩ
				±250	$400 \text{ m}\Omega \leq R < 600 \text{ m}\Omega$
				±200	600 mΩ≤R<1000 mΩ
				±1500	10 mΩ≦R<37 mΩ
				±1200	37 mΩ≤R<60 mΩ
RTT03	1/10W	3.16A	7.91A	±600	60 mΩ≦R<100 mΩ
(0603)				±300	100 mΩ≦R<200 mΩ
				±600	200 mΩ≦R<500 mΩ
				±400	500 mΩ≤R<1000 mΩ
				±1500	$10 \text{ m}\Omega \leq R < 19 \text{ m}\Omega$
RTT05	1/8W	2 52 4	0.004	±1200	$ 19 \text{ m}\Omega \leq \text{R} < 33 \text{ m}\Omega $ $ 33 \text{ m}\Omega \leq \text{R} < 50 \text{ m}\Omega $
(0805)	1/077	3.53A	8.82A	±800 ±600	50 mΩ≤R<100 mΩ
				±200	100 mΩ≤R<1000 mΩ
				±1500	$10 \text{ m}\Omega \leq R < 19 \text{ m}\Omega$
				±1200	$19 \text{ m}\Omega \leq R < 25 \text{ m}\Omega$
RTT06	1/3W	5.77A	14.42A	±1000	$25 \text{ m}\Omega \leq \text{R} < 50 \text{ m}\Omega$
(1206)	17011	0.777	11.12/	±600	$50 \text{ m}\Omega \leq \text{R} < 100 \text{ m}\Omega$
				±200	100 mΩ≤R<1000 mΩ
				±1500	10 mΩ≦R<19 mΩ
				±1000	19 mΩ≦R<25 mΩ
RTT12	1/2W	7.07A	17.67A	±700	25 mΩ \leq R $<$ 50 mΩ
(1210)			17.077	±400	50 mΩ≦R<100 mΩ
				±200	100 mΩ \leq R $<$ 1000 mΩ
				±1500	10 mΩ \leq R $<$ 19 mΩ
				±1200	19 m Ω \leq R $<$ 25 m Ω
RTT18	3/4W	8.66A	21.65A	±900	25 mΩ \leq R $<$ 50 mΩ
(1812)	3/444	0.00A	21.05A	±500	$50~\text{m}\Omega\!\leq\!R\!<\!100~\text{m}\Omega$
				±200	100 m Ω \leq R $<$ 1000 m Ω
				±200	100 mΩ \leq R $<$ 1000 mΩ
				±1500	10 m Ω \leq R $<$ 19 m Ω
RTT20				±1200	19 mΩ \leq R $<$ 25 mΩ
(2010)	3/4W	8.66A	21.65A	±900	25 mΩ≤R<50 mΩ
. ,				±500	50 mΩ≤R<100 mΩ
				±200	100 mΩ≤R<1000 mΩ
				±1500	10 mΩ≦R<19 mΩ
RTT25	4,	40.5	05.	±1200	19 mΩ≦R<25 mΩ
(2512)	1 W	10A	25A	±900	25 mΩ≦R<50 mΩ
				±500	50 mΩ≤R<100 mΩ
		n was also date and		±200	100 mΩ≦R<1000 mΩ
	使用	月溫度範圍			-55°C ~ +155°C

備	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章 DATA Center.
註		Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	3/13

3.3 功率衰減曲線:

型別	RTT01 (0201)	其它
使用		
温度	-55°C ~ +125°C	-55°C ~ +155°C
範圍		
說明	周圍溫度若超過70℃至125℃之間,功率可照下	
	圖曲線予以修定之。	圆曲線予以修定之。
功率衰減曲線圖	100 負 80 載 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -55 20 40 60 80 100 120 140 160 環境溫度(℃)	100 負 80 載 功 60 率 比 40 (%) 20 -55 20 40 60 80 100 120 140 160 環境溫度(℃)

3.4 額定電壓或額定電流:

3.4.1 阻值範圍:≧1Ω

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。

可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電壓為其 額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$
 E=額定電壓(V) P=額定功率(W)

 $R=公稱阻值(\Omega)$

3.4.2阻值範圍: <1Ω

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。

可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電流為其 額定電壓。

$$I = \sqrt{P/R}$$
 I =額定電流(A) P=額定功率(W)

R=公稱阻值(Ω)

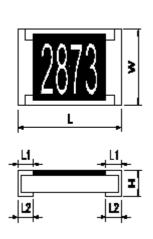
備註	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章 DATA Center.
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	4/13

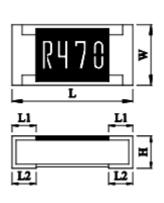
4 尺寸:

4.1 阻值範圍:≧1Ω & 0Ω



						Unit:mm
	Dimension					
		L	W	Н	L1	L2
Туре	Size Code					
RTT01	0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.23±0.03	0.15±0.05	0.15±0.05
RTT02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.25±0.10
RTT03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15
RTT05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.15
RTT06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.35±0.15
RTT18	1812	4.40±0.20	3.15±0.20	.0.47±0.20	0.60±0.20	0.60±0.01
RTT12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTT20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20
RTT25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20

4.2 阻值範圍: <1Ω



						Unit:mm
	Dimension	٦	W	Н	L1	L2
Туре	Size Code					
RTT02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.10	0.25±0.10	0.20±0.15
RTT03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.25±0.15	0.35±0.15
RTT05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.20
RTT06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.65±0.15
RTT12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTT18	1812	4.40±0.20	3.15±0.20	.0.47±0.20	0.60±0.20	0.60±0.01
RTT20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20
RTT25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20

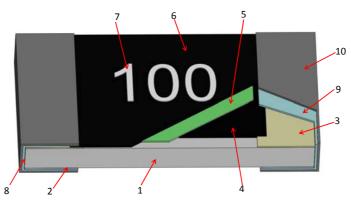
備註	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章 DATA Center.
註		Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	5/13

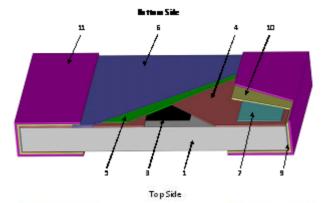
5 結構圖:

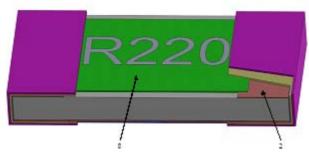
5.1 阻值範圍:≥1Ω & 0 Ω



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

5.2 阻值範圍:<1Ω





1	陶瓷基板	Ceramic substrate	7	2nd 正面內部電極	2nd Top inner electrode
2	1st 正面內部電極	1st Top inner electrode	8	G2+MK層	G2 layer+Marking
3	電阻層	Resistive layer	9	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	背面內部電極	Bottom inner electrode	10	Ni層電鍍	Ni plating
5	1st保護層	1st Protective coating	11	Sn層電鍍	Sn plating
6	2nd保護層	2nd Protective coating			

備	非發行官制义件	發行管制章 DATA Center.
		00
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	6/13

6 信賴性試驗項目: 6 1 雷甸性能試驗(Flectrical Performance Test)

6.1 電氣性的	能試驗(Electrical Performance Test)			
Item	Conditions	Specifications規格		
項目	條件	Resistors	Jumper	
Temperature Coefficient of Resistance 溫度係數	$\frac{(R2-R1)}{R1(T2-T1)} \times 10^6$ R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2:-55 $^{\circ}$ C或+125 $^{\circ}$ C下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度($^{\circ}$ C) T2:-55 $^{\circ}$ C或+125 $^{\circ}$ C之溫度($^{\circ}$ C) \circ	參考3.規格表	NA	
	依據 JIS-C5201-1 4.8			
Overload	施加2.5倍的額定電壓5秒,靜置30分鐘以上再量測阻值變化率。 (額定電壓值請參考 3.規格表) Jumper:施加最高過負荷電流: 型別 RTT01 RTT02 RTT03 RTT05 RTT06 RTT12 RTT18 RTT20 RTT25 (0201) (0402) (0603) (0805) (1206) (1210) (1812) (2010) (2512)	1.阻值範圍:≥1Ω 0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω 1%、 2%、5%:±(2.0%+0.001Ω)		
	±5% 1.25A 2.5A 2.5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A ±1% 1.25A 3.75A 5A 6.25A 8.75A 10A 12.5A 12.5A 17.5A 依據 JIS-C5201-1 4.13	外觀無損傷,無短路或燒毀現象。		
Resistance	將晶片電阻置於治具上,在正負極施加100 VDC一分鐘後測量電極與保護層及電極與基板(底材)之絕緣電阻值。依據 JIS-C5201-1 4.6	\geq 10 Ω		
Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓	將晶片電阻置於治具上,在正、負極施加VAC(參考下列) RTT05、06、12、18、20、25 用500 VAC-分鐘 RTT01、02、03用300 VAC-分鐘 依據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。		
Intermittent	置於恆溫箱中,施加2.5倍額定電壓,1秒ON,25秒OFF,	1.阻值範圍:≧1Ω	參考3.	
Overload	計10000+400/-0次後取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。 Jumper:施加最高過負荷電流		規格表	
Noise Level 雜音測驗	依據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。	阻値範圍 雑音(Noise) $R < 100\Omega \qquad \leq -10 db \ (0.32 \text{ uV/V}) \\ 100\Omega \subseteq R < 1K\Omega \qquad \leq 0 db \ (1.0 \text{ uV/V}) \\ 1K\Omega \subseteq R < 10K\Omega \qquad \leq 10 db \ (3.2 \text{ uV/V}) \\ 10K\Omega \subseteq R < 100K\Omega \qquad \leq 15 db \ (5.6 \text{ uV/V}) \\ 100K\Omega \subseteq R < 1M\Omega \qquad \leq 20 db \ (10 \text{ uV/V}) \\ 1M\Omega \subseteq R \qquad \leq 30 db \ (32 \text{ uV/V})$	NA	

備	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章 DATA Center.
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2014/11/28頁 次7/13

6.2 機械性能試驗(Mechanical Performance Test)

	試驗(Mechanical Performance Test)		
Item	Conditions	Specifications規格	
項目	條件	Resistors	Jumper
	用R0.5的測試探針在本體中央向下施加10N { 0.2 kgf }	1.阻值範圍:≧1Ω	參考3.
	負載持續10 sec.。	±(1.0%+0.05Ω)	規格表
Strength 1.R	RTT02、RTT03測試探針R0.2	2.阻值範圍:<1Ω	
本體強度 2.R	RTT05、06、12、18、20、25測試探針R0.5	±(1.0%+0.001Ω)	
依扌	據 JIS-C5201-1 4.15	外觀無損傷,側導無裂痕	
	試項目一:將電阻焊在電路板上,在電阻背面施以5N的力	項目一: 外觀無損傷,無側導脫落	及本體斷
Strength	量持續10 sec後,檢查側導體外觀。	裂發生。	
端電極	(RTT01:3N)	項目二: RTT01≧3N	
拉力測試 測詞	試項目二:將電阻焊在電路板上,逐漸施加力量於電阻背	其它≧5N	
	面,測試端電極最大剝離強度。		
依才	據 JIS-C5201-1 4.16		
	於20~25℃異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後,取出靜置48 hr以上,再	1.阻值範圍:≥1Ω	參考3.
	測阻值變化率。	ļ	規格表
耐溶劑性 試驗		型別 RTT01 其他	
63人/列双		$\triangle R\% \pm (1.0\% + 0.05\Omega) \pm (0.5\% + 0.05\Omega)$	
		2.阻值範圍:<1Ω	
		±(1.0%+0.001Ω)	
	W. HO OFFICA 4 4 400	外觀無損傷,無G2保護層及錫層被Le	aching現
	據 JIS-C5201-1 4.29	家。	
	處理:將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、	导體吃鋤面槓應大於95%。	
	度100%及氣壓1.22×10 ⁵ pa的飽和條件下進行4小時的		
	化測試,取出後靜置於室溫下2小時。		
	試方法:將電阻浸於235±3℃之爐中2±0.5秒後取出置於		
	微鏡下觀察焊錫面積。		
	據 JIS-C5201-1 4.17		6 1 6
	測試項目一(焊錫爐測試):	試驗項目一:	參考3.
l look	於260+5/-0℃之錫爐中10 秒+1/-0,取出靜置60分鐘以		規格表
九焊錫熱 上	,再量測阻值變化率。	1.阻值範圍:≧1Ω	
· ·		$\Delta R\% = \pm (1.0\% + 0.05\Omega)$	
	測試項目二(焊鍚爐測試):	2.阻值範圍:<1Ω	
	於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒,取出後洗淨。置於顯		
微鉛	鏡下觀察焊錫面積。	(2).電極外觀無異常,無側導脫落。	
(a)	别是历口一/雨边胜是瓜)。	試驗項目二:	
	測試項目三(電烙鐵試驗): + ※ œ :250:10℃	(1).導體吃錫面積應大於95%。	
		(2).在電極邊緣處不應見到下層的	
	35(N=)((-4) 1-11-0); C C C C C	物質(例如白基板)。	
	電鉻鐵加熱於電極兩端後,取出靜置60鐘以上,再量測 值變化率。	1/7月(17月以口	
	pa 2.10	試驗項目三:	
		(1).阻值變化率	
1		1.阻值範圍:≥1Ω	
1			1
		ΔR%=±(1.0%+0.05Ω)	
17: 1	據 .US-C5201-1 4 18	ΔR%=±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω	
依扎	據 JIS-C5201-1 4.18		

備	非發行管制文件	發行管制章 DATA Center.
	自行注意版本更新	
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2014/11/28頁 次8/13

Item	Conditions	Specifications規格	
項目	條件	Resistors	Jumpe
Joint Strength of Solder 焊錫粘合強度	i i	試驗項目一:	Jumpe 参考3. 規格表
Vibration	(Arrount of band) (Arrount of band) (依據JIS-C5201-1 4.33	1.阻值範圍:≧1 Ω	(A # 2)
耐振性試驗	將晶片電阻焊於測試板上施加一振動波 震動頻率:10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz/分 振幅:1.5 mm 測試時間:6 hr (X.Y.Z3個方向各2 hr) 依據 JIS-C5201-1 4.22	1.阻值範圍.至 1 Ω 0.1%、0.5%、1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5%:±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1 Ω 1%、2%、5%:±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷	參考3. 規格表

備	非發行管制文件自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2014/11/28頁次9/13

6.3 環境試驗(Environmental Test)

Item	Condition	ıs		Spe	cifications規格	
項目	條件				istors	Jumper
Resistance	置於155±5℃之烤箱中1000+48/-0 hrs,取出静置1 hr以上		1.阻值範圍:≧10)	參考3.	
to Dry Heat	再量測阻值變化率。 PS:RTT01置於125±3℃中。		0.1% \ 0.5% \ 1%	` ,	規格表	
耐熱性試驗				:±(2.0%+0.10Ω)		
				2.阻值範圍:<10		
	依據 JIS-C5201-1 4.25			1%、2%、5%:5	<u>ξ(1.0%+0.00 Ω)</u> 短路及燒毀現象。	
Th 1		÷ 4 55°0 45	0 km . 405			
Thermal Shock	將晶片電阻置入冷熱沖擊機中,溫					參考3.
冷熱沖擊	℃ 15分鐘,共計循環300次後取	出,靜置60分針		0.1% \ 0.5% \ 1%	%:±(0.5%+0.05Ω) %:±(1.0%+0.05Ω)	規格表
冷然件学	值變化率。			2.阻值範圍:<10		
	測試條件			1%、 2%、5% ::		
	最低溫度	-55±5℃			短路及燒毀現象。	
	最高溫度	125±5℃			70 7	
	溫度保留時間	15分				
	依據 MIL-STD 202 Method 107					
Loading Life	置於溫度40±2℃相對濕度90~95%	6恆溫恆濕槽中	', 並施加	1.阻值範圍:≧10	Ω	參考3.
in Moisture	額定電壓,90分鐘ON,30分鐘O	FF,共1,000 l	hrs取出靜		1	規格表
耐濕負荷	置60分鐘以上再量測阻值變化率	0		型別 RTT01	其他型別	
				1%: (1.0%+0.05Q)	0.1% \ 0.5% \ 1%: (0.5%+0.05Ω)	
				範圍 (1.0%+0.05Ω) 5%:	2% \ 5%:	
				(3.0%+0.1Ω)	(2.0%+0.10Ω)	
				2.阻值範圍:<1(1%、2%、5%:±(
	依據 JIS-C5201-1 4.24				<u>ξ</u> 短路及燒毀現象	0
Load Life	 置於70±2℃之烤箱中施加額定電	廊,00八倍○N	1,30八倍	<u>1.阻值範圍:≥10</u>		參考3.
	OFF,共1,000 hrs取出靜置60分鐘			1. 压阻轧阻 三工	2	参写5. 規格表
XAM	四十六八,000 1113年出射重00分類	E以工行里 例位	- 但发10十	型別 RTT01	其他型別	外位在农
				1%:	0.1% \ 0.5% \ 1%:	
				範圍 (1.0%+0.05Ω) 5%:	(0.5%+0.05Ω) 2% \ 5%:	
				$(3.0\% + 0.1\Omega)$	(2.0%+0.10Ω)	
				2.阻值範圍:<10		
	依據 JIS-C5201-1 4.25			1% × 2% × 5% :±(
					禁短路及燒毀現象	
Low	將晶片電阻放置-55℃恆溫箱中60		. –	1.阻值範圍:≧10		參考3.
Temperature	1 - 1 - 10 - 1 - N - 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I	置8±1 hrs再量》	則阻值變化	0.1% \ 0.5% \ 1%		規格表
Operation	率。			2%、5% 2.阻值範圍:<1 (:±(1.0%+0.05Ω)	
低溫操作				2.阻狙•阻.< 1. 1%、2%、5%:±		
	依據MIL-R-55342D 4.7.4				<u>(1.0%+0.00112)</u> E短路及燒毀現象	0
				丌 既無狽汤 ? 無	加州以党政坑豕	-

備	非 贺 仃 官 制 又 件	發行管制章 DATA Center.
註		Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	10/13

Item	Conditions		Specifications規格			
項目		條件	ļ.		Resistors	Jumper
Whisker	◎測試項	目(冷熱衝擊測試):			Whisker長度在50µm之內。	
試驗	將晶片電	阻置放於冷熱衝擊試	驗箱內,並依下列	條件做測		
	試,試驗	後置於室溫下2小時。				
		測試係	条件			
		最低儲存溫度	-55+0/-10℃			
		最高儲存溫度	85+10/-0°C			
		溫度保留時間	10分			
		温度循環次數	1,500			
	◎檢查:將放大鏡的倍數調至40或大於40的倍數下做視			下做視		
	察和測試,如果此方法難做出判斷,我們可以改用掃描					
	電子顯微鏡(SEM),且將倍數調至1000或大於1000倍數					
	下做視察	下做視察和測試。				
	依據JES	D- Standard NO.22A	121 class2.			

備註	非發行管制文件自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
註		Series No. 60

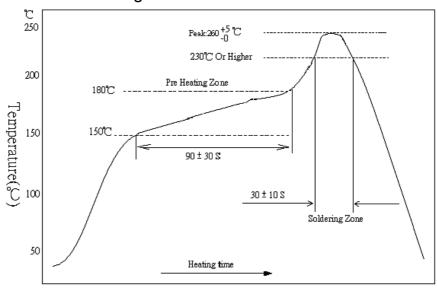
RALEC
旺詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	11/13

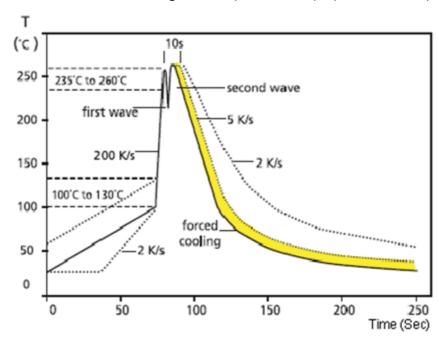
7 建議焊錫條件:

7.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile



備註:零件最高耐溫 260 +5/-0 [℃],10 秒。

7.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)



7.3 烙鐵焊錫方法:350±10℃ 3秒之內。

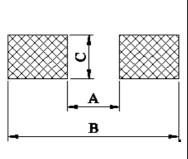
備	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章 DATA Center.
註		Series No. 60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	12/13

8 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering):

Unit:mm

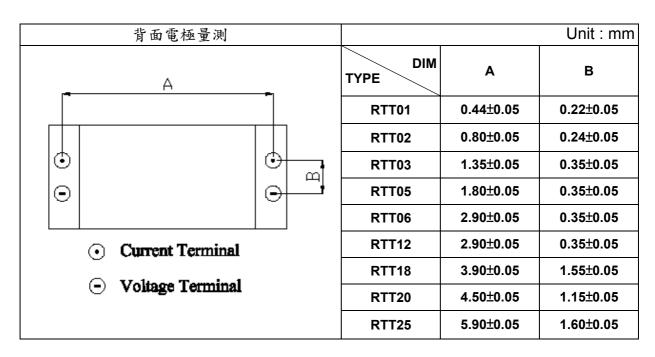


DIM TYPE	Α	В	С
RTT01	0.3	1.0	0.4
RTT02	0.5	1.5	0.6
RTT03	0.8	2.1	0.9
RTT05	1.2	3.0	1.3
RTT06	2.2	4.2	1.6
RTT12	2.2	4.2	2.8
RTT18	3.1	5.9	3.0
RTT20	3.5	6.1	2.8
RTT25	3.8	8.0	3.5

9 鍍層厚度:

- 9.1 鎳層厚度:≧2 µ m
- 9.2 純錫:≧3 μ m
- 9.3 電鍍純錫為霧錫

10 阻值測試包裝標準量測位置:



備	非發行管制文件自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

RALEC	
旺詮	

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2014/11/28
頁 次	13/13

11 储存期限:

11.1 在儲存環境25±5℃、60±15%之條件下可儲存二年。

12 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)



13 附件:

13.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

備	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章 DATA Center.	
註		Series No. 60	